



江苏海矽美电子科技有限公司

TO-263M-2L超薄封装 SiC MOSFET产品介绍



目录

产品特点

产品尺寸

产品优势

产品目录



描述

江苏海矽美推出具体一定特色的TO-263M-2L超薄款封装形式的第三代半导体SiC MOSFET产品。

TO-263M-2L超薄封装产品，可与常规的TO-263-2L实行引脚兼容，但是其封装塑封体厚度与传统TO-263相比，厚度减少了约60%，此封装形式产品可满足工规要求，湿敏等级可通过MSL-1，对比常规的TO-277、DFN封装，可以最大限度提高额定功率，实现小型化和节省空间的设计，可满足一些产品相对空间有限，但是其功率密度要求较高的场所。

TO-263M-2L超薄封装的SiC MOSFET产品涵盖 650V电压等级，导通电阻额定值覆盖 100mΩ 至540mΩ。

薄型表面贴片封装 TO-263M

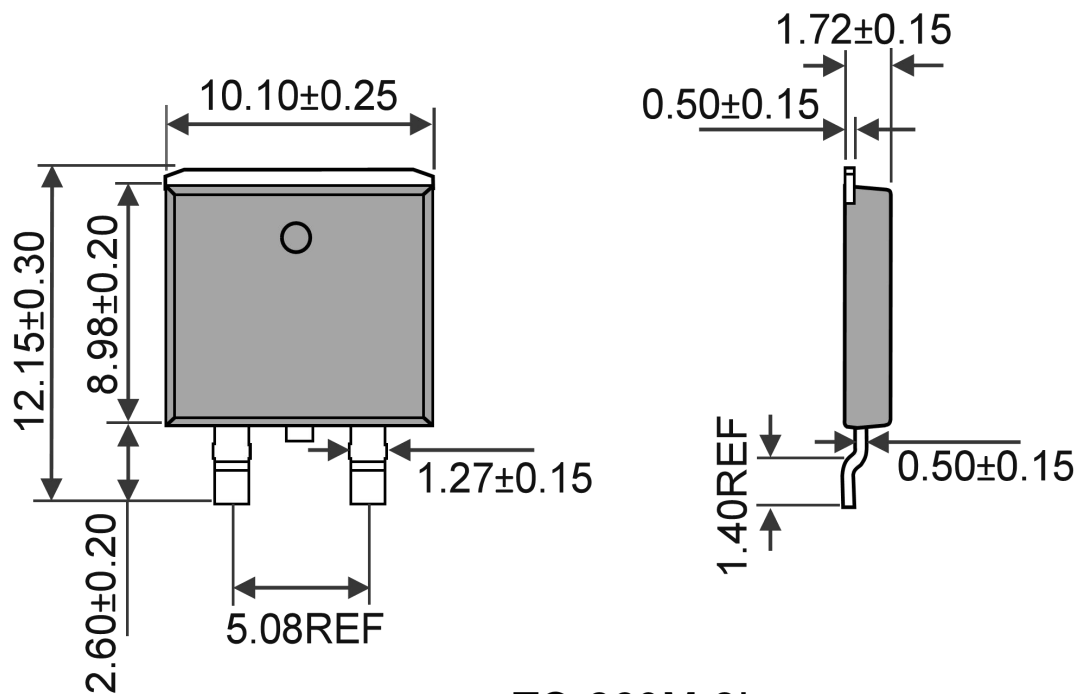


特点

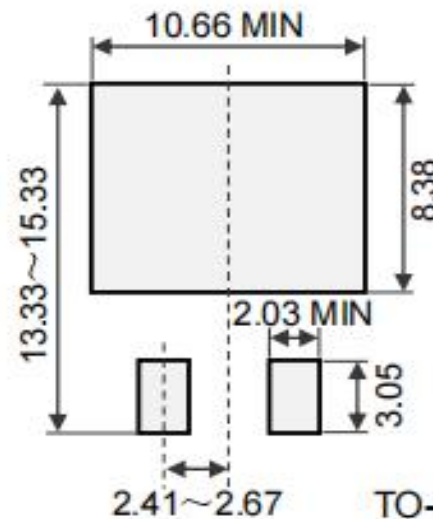
- 低高度（1.7mm典型值）
- 高散热化
- 可同TO-263-2L封装实行引脚兼容
- 提升效率
- 可提供工规产品
- 对比TO-277、DFN封装，可以最大限度提高额定功率，实现小型化和节省空间的设计。
- 符合ROHS、SVHC、无卤等环保要求
- 通过MSL-1湿敏等级

产品尺寸

• TO-263M封装尺寸



TO-263M-2L
Unit:mm

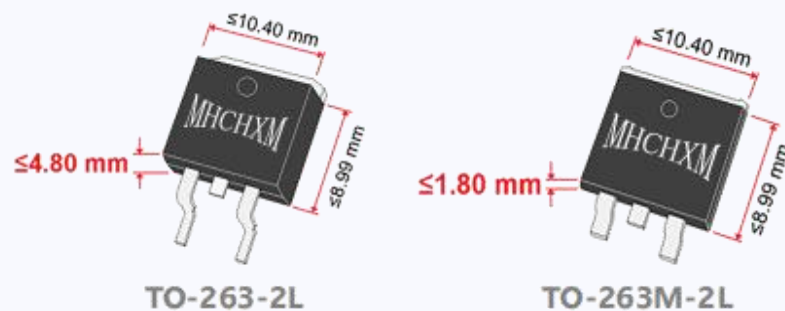
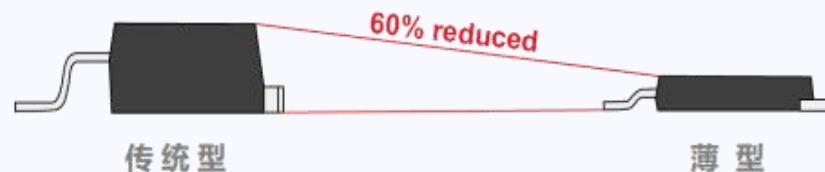


TO-263M-2L
Unnoted Tolerance: ± 0.05
Unit:mm

- 低厚度：与传统TO-263相比，厚度减少了约60%
- 兼容性：TO-263M与TO-263外形设计相似，具备兼容性
- 高散热化：TO-263M芯片与外部端子通过铝带连接，扩大散热面积，实现高散热效果

产品优势---263M超薄产品

为满足产品的应用，以及产品**轻薄化**，海矽美自主研发推出TO-263M超薄款，比常规TO-263厚度减薄60%。



● SiC MOSFET

Part Number	Process type	Package	Polarity	VDSS(V)	ID(A)	VGS(th) _Min (V)	VGS(th) _Max (V)	<u>Rdson@VGS1</u> <u>5V TYP(mΩ)</u>	<u>Rdson@VGS</u> <u>15V Max(mΩ)</u>	<u>Rdson@VGS</u> <u>18V TYP(m</u> <u>Ω)</u>	<u>Rdson@VGS</u> <u>18V Max(m</u> <u>Ω)</u>	Qg_Typ (nC)	Ciss_Typ (pF)
HXMC65N100M3	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	28	2.4	4	130	200	100	150	18.9	522
HXMC65N160M3	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	17	2.4	4	190	268	160	220	12.6	448
HXMC65N300M3	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	10	2.4	4	380	530	300	420	6.3	224
HXMC65N130M1	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	20	2.7	4.5	190	250	130	190	28.6	491
HXMC65N190M1	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	16	2.7	4.5	260	330	190	220	25	375
HXMC65N250M1	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	11	2.7	4.5	380	500	250	380	21.3	254
HXMC65N380M1	SiC MOSFET	TO-263M-2L	N	650	9.3	2.7	4.5	580	720	380	550	27	190

MHCHXM[®]
Inspiring Power



江苏海矽美
微信公众号



江苏海矽美
官网